

**薄膜材料デバイス研究会 第19回研究集会「新半導体材料・デバイス：SDGs実現へ向けて」
タイムテーブル（1日目）**

日付	時間	セッション	備考	座長(案)	
11/17 (木)	9:55 - 10:00	チュートリアル： イントロダクトリー 市川 和典 (松江高専)	響都ホール オンライン配信	古田 守 (高知工大)	
	10:00 - 11:00	チュートリアル1： (招待講演) ディスプレイデバイスの最新技術動向 小野 記久雄 (サークル・クロス・コーポレーション フェローアナリスト)			
	11:00 - 12:00	チュートリアル2： (招待講演) 酸化ガリウムの薄膜形成技術とその開発動向 西中 浩之 (京都工繊大)			
	12:00 - 13:00	昼食 (60分)			川原村 敏幸 (高知工大)
	13:00 - 14:00	ランブセッション1： (特別招待講演) FLOATING-GATE MEMORY - The Prime Technology Driver of THE 4th INDUSTRIAL REVOLUTION - Prof. Simon. M. Sze (National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan, ROC)			葉 文昌 (島根大学)
	14:00 - 14:10	開会式 実行委員長 神谷 利夫 (東工大)			
	14:10 - 15:50	オールラウンドセッション1：メモリーデバイスの最新動向 14:10~14:50 (招待講演) 「酸化物半導体を用いた三次元集積メモリーデバイスの研究動向」 小林 正治 (東京大学) 14:50~15:10 「溶液プロセスによるIn-Sn-O(ITO)薄膜の形成と強誘電体ゲート薄膜トランジスタへの応用」 久保田 剛郎 (北陸先端大) 15:10~15:30 「塗布形成した電荷蓄積層を有する不揮発性有機トランジスタメモリにおけるシナプス特性」 森川 和慶 (大阪公立大) 15:30~15:50 「ミストCVD法によるアモルファスGa-Al-O薄膜デバイスのメモリスタ特性」 伊藤 良 (龍谷大)	響都ホール オンライン配信	浦岡 行治 (奈良先端大) 井手 啓介 (東工大)	
	15:50 - 16:05	企業コマーシャル①・休憩			
	16:05 - 17:45	オールラウンドセッション2：IV族材料・デバイスの新展開 16:05~16:45 (招待講演) 「溶液プロセスによるシリコン量子ドットとLEDの作製」 齋藤 健一 (広島大) 16:45~17:05 「 μ CLBS法を用いたGeの単結晶帯成長」 大里卓司 (島根大) 17:05~17:25 「自己整合ダブルゲートCu-MIC p-ch poly-Ge TFTのGe膜厚による性能変化」 鈴木 翔 (東北学院大) 17:25~17:45 「IV 族三元混晶の薄膜合成と高熱電性能実証」 前田 真太郎 (筑波大)		黒木 伸一郎 (広島大) 都甲 薫 (筑波大)	
	17:45 - 18:00	企業コマーシャル②・休憩			
	18:00 - 18:20	会場移動			
	18:20 - 20:00	ランブセッション2：酸化物TFTの物理 18:20~19:00 (招待講演) 「低温デバイスプロセスのためのイオン注入技術の検討」 安田 圭佑 (日新イオン機器(株)) 19:00~19:20 「Suppressing Hydrogen Diffusion and Enhancing Reliability of Short-channel InGaZnO Thin Film Transistors by Bottom-gate Oxide Engineering」 Kuan Ju Zhou (National Sun Yat-Sen University, Taiwan) 19:20~19:40 「H-W法による原子状態素処理の非晶質In-Sn-Zn-O薄膜トランジスタへの信頼性評価」 玉井 隆一 (日大) 19:40~20:00 「Thermopower Modulation Analyses of High-mobility Transparent Amorphous Oxide Semiconductor InSnZnO _x Thin-Film Transistors」 Hui Yang (北大)	マリアージュグランデ 配信なし	古田 守 (高知工大) 曲 勇作 (北大)	

**薄膜材料デバイス研究会 第19回研究集会「新半導体材料・デバイス：SDGs実現へ向けて」
タイムテーブル（2日目）**

日付	時間	セッション	備考	座長(案)
11/18 (金)	9:30 - 11:10	<p>オールラウンドセッション3：新奇薄膜材料・新奇デバイス</p> <p>9:30～10:10 (招待講演) 「ハロゲン化物エレクトロニクス展望および課題」 Junghwan Kim (東工大)</p> <p>10:10～10:30 「水素添加多結晶In-Ga-0 (IG0:H) 薄膜の金属-半導体遷移制御と 薄膜トランジスタ応用」 松村 俊宏 (高知工大)</p> <p>10:30～10:50 「超高真空スパッタリング装置を用いた高移動度多結晶Zn₃N₂薄膜」 清水 篤 (東工大)</p> <p>10:50～11:10 「Solid-State Electrochemical Thermal Transistors based on Sr(Co_{1-x}Fe_x)O_y (0 ≤ x ≤ 1, 2 ≤ y ≤ 3) Films as Active Layers」 Zhiping Bian (北大)</p>	響都ホール オンライン配信	太田 裕道 (北大) 市川 和典 (松江高専)
	11:10 - 11:25	企業コマース③・休憩		
	11:25 - 12:45	<p>オールラウンドセッション4：薄膜の物理・化学</p> <p>11:25～11:45 「Room Temperature Insulator-to-Metal Transition of Strained VO₂/TiO₂ Multilayered Films」 Binjie Chen (北大)</p> <p>11:45～12:05 「ZnO中の水素複合欠陥」 Xinyi He (東工大)</p> <p>12:05～12:25 「原子状水素アニールによる半導体と金属の自然酸化膜と熱酸化膜の還元」 部家 彰 (兵庫県大)</p> <p>12:25～12:45 「タンパク質分子接合を含むCNTサブモノレイヤーFETによる電荷輸送特性評価」 森岡 璃久 (奈良先端大)</p>		木村 睦 (龍谷大) 春田 正和 (近畿大)
	12:45 - 13:40	昼食		
	13:40 - 14:15	ショートプレゼンテーション	響都ホール オンライン配信	葉 文昌 (島根大) 野々口 斐之 (京都工繊大)
	14:15 - 15:45	ポスターセッション	響都ホール (配信なし)	
	15:45 - 17:25	<p>オールラウンドセッション5：パワーデバイスの新展開</p> <p>15:45～16:25 (招待講演) 「自動車用パワーデバイス開発の現状とキー課題」 三宅裕樹 ((株)ミライズテクノロジー)</p> <p>16:25～16:45 「スパッタリング法によるアルファス酸化ガリウム薄膜の作製とダイオード特性の評価」 嵯峨野 太一 (東工大)</p> <p>16:45～17:05 「Development of a Real-Time Temperature Measurement Technique for SiC Wafer During Rapid Plasma Processing Based on Optical-Interference Contactless Thermometry (OICT)」 Jiawen Yu (広島大)</p> <p>17:05～17:25 「p型二硫化モリブデンTFTの原子状酸素処理及びアニール処理による特性改善」 荒井 大地 (日大)</p>	響都ホール オンライン配信	川原村 敏幸 (高知工大) 西中 浩之 (京都工繊大)
	17:25 - 17:40	企業コマース④・休憩 15分		
	17:40 - 18:00	閉会式、アワード		

11月17日(木)

チュートリアル

09:55-10:00 インTRODクトリー

市川 和典

松江高専

10:00-11:00 17a-T01 ディスプレイデバイスの最新技術動向 (招待講演)

小野 記久雄

サークル・クロス・コーポレーション

11:00-12:00 17a-T02 酸化ガリウムの薄膜形成技術とその開発動向 (招待講演)

西中 浩之

京都工繊大

12:00-13:00 昼食

ランプセッション 1: 特別招待講演

13:00-14:00 17a-R01 FLOATING-GATE MEMORY - The Prime Technology Driver of THE 4th INDUSTRIAL REVOLUTION - (特別招待講演)

S. M. Sze

National Yang Ming Chiao Tung University

開会式

14:00-14:10 神谷 利夫 (第19回研究集会 実行委員長)

東工大

オーラルセッション 1 : メモリデバイスの最新動向

14:10-14:50 17p-I01 酸化物半導体を用いた三次元集積メモリデバイスの研究動向 (招待講演)

小林 正治

東京大学

14:50-15:10 17p-O01 溶液プロセスによる In-Sn-O(ITO)薄膜の形成と強誘電体ゲート薄膜トランジスタへの応用

久保田剛郎^{1,*}, 徳光永輔¹⁾

¹⁾ 北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科

15:10-15:30 17p-O02 塗布形成した電荷蓄積層を有する不揮発性有機トランジスタメモリにおけるシナプス特性

森川和慶^{1,*}, 中川和紀¹⁾, 永瀬隆^{1,2)}, 小林隆史^{1,2)}, 内藤裕義^{1,2)}

¹⁾ 大阪公立大学 大学院 工学研究科 ²⁾ 大阪公立大学 分子エレクトロニックデバイス研究所

15:30-15:50 17p-O03 ミストCVD法によるアモルファスGa-Al-O薄膜デバイスのメモリスタ特性

伊藤 良^{1,*}, 杉崎 澄生¹⁾, 嶽山 嵐¹⁾, 松田 時宜²⁾, 河西 秀典¹⁾, 木村 睦¹⁾

¹⁾ 龍谷大学 理工学研究科 電子情報学専攻 ²⁾ 近畿大学 理工学部 電気電子通信工学科 ³⁾

15:50-16:05 企業コマースナル1・休憩

オーラルセッション2：IV族材料・デバイスの新展開

16:05-16:45 17p-I02 溶液プロセスによるシリコン量子ドットとLEDの作製 (招待講演)

齋藤 健一
広島大学

16:45-17:05 17p-O04 μ CLBS法を用いたGeの単結晶帯成長

大里卓司^{*}, 葉文昌
島根大学 自然科学研究科

17:05-17:25 17p-O05 自己整合ダブルゲートCu-MIC p-ch poly-Ge TFTのGe膜厚による性能変化

鈴木翔^{1,*}, 原明人¹⁾
¹⁾ 東北学院大学 工学研究科 電子工学専攻

17:25-17:45 17p-O06 IV族三元混晶の薄膜合成と高熱電性能実証

前田真太郎^{1*}, 石山隆光¹⁾, 末益崇¹⁾, 都甲薫¹⁾
¹⁾ 筑波大院数理物質

17:45-18:00 企業コマースナル2・休憩

1800-18:20 会場移動

ランプセッション2：酸化物TFTの物理

18:20-19:00 17p-R01 低温デバイスプロセスのためのイオン注入技術の検討 (招待講演)

安田 圭佑^{*}, 永尾 友一, 山根 裕也, 宇井 利昌
日新イオン機器株式会社

19:00-19:20 17p-R02 Suppressing Hydrogen Diffusion and Enhancing Reliability of Short-Channel InGaZnO Thin Film Transistors by Bottom-Gate Oxide Engineering

K. Zhou^{1,*}, K. Ide²⁾, T. Katase²⁾, T. Kamiya^{2,3)}, B. Huang¹⁾, P. Yen¹⁾, T. Chang¹⁾ and S.M. Sze⁴⁾
¹⁾ Department of Physics, National Sun Yat-Sen University, ²⁾ Laboratory for Materials and Structures, Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology, ³⁾ MDX Research Center for Element Strategy, Tokyo Institute of Technology, ⁴⁾ Institute of Electronics, National Yang Ming Chiao Tung University

19:20-19:40 17p-R03 H-W法による原子状酸素処理の非晶質In-Sn-Zn-O薄膜トランジスタへの信頼性評価

玉井隆一^{1*}, 清水耕作¹⁾
¹⁾ 日本大学大学院 生産工学研究科

19:40-20:00 17p-R04 Thermopower Modulation Analyses of High-Mobility Transparent Amorphous Oxide Semiconductor InSnZnO_x Thin-Film Transistors

H. Yang^{1,2)}, Y. Zhang^{3,4)}, Y. Matsuo¹⁾, Y. Magari^{1,5)} and H. Ohta^{1,*}
¹⁾ Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University, ²⁾ Institute of Optoelectronic Technology, Beijing Jiaotong University, ³⁾ Institute of Quantum and Sustainable Technology, Jiangsu University, ⁴⁾ Foshan (Southern China) Institute for New Materials, ⁵⁾ Graduate School of Natural Science and Technology, Shimane University

11月18日(金)

オーラルセッション3：新奇薄膜材料・新奇デバイス

- 09:30-10:10 **18a-I01** ハロゲン化物エレクトロニクスの展望および課題 (招待講演)
Junghwan Kim
東京工業大学 国際先駆研究機構 元素戦略MDX 研究センター
- 10:10-10:30 **18a-O02** 水素添加多結晶 In-Ga-O (IGO:H)薄膜の金属-半導体遷移制御と 薄膜トランジスタ応用
松村 俊宏 (1,*), 岡本 直樹 (1), 佐々木 大地 (3), 霍間 勇輝 (3), 川嶋 絵美 (3), 古田 守 (1,2)
(1) 高知工科大学 マテリアル工学コース (2) 高知工科大学 総合研究所ナノテクノロジー研究センター (3) 出光興産(株) 次世代技術研究所 先端無機材料研究室
- 10:30-10:50 **18a-O03** 超高真空スパッタリング装置を用いた高移動度多結晶 Zn₃N₂ 薄膜
清水篤^{1,*}, 井手啓介¹, 片瀬貴義¹, 平松秀典^{1,2}, 細野秀雄², 神谷利夫^{1,2}
¹ 東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所 ² 東京工業大学 元素戦略研究センター
- 10:50-11:10 **18a-O04** Solid-State Electrochemical Thermal Transistors Based on Sr(Co_{1-x}Fe_x)O_y (0 ≤ x ≤ 1, 2 ≤ y ≤ 3) Films as Active Layers
Z. Bian^{1,*}, Q. Yang², M. Yoshimura³, J. Lee⁴, H. Jeon⁴, J. Lin⁵, B. Feng⁵, Y. Ikuhara⁵, H.J. Cho⁶ and H. Ohta⁶
¹ Information Science and Technology, Hokkaido University, ² Institute of Quantum and Sustainable Technology, Jiangsu University, ³ School of Engineering, Hokkaido University, ⁴ Department of Physics, Pusan National University, ⁵ Institute of Engineering Innovation, The University of Tokyo, ⁶ Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University

11:10-11:25 企業コマースナル3・休憩

オーラルセッション4：薄膜の物理・化学

- 11:25-11:45 **18a-O05** Room Temperature Insulator-to-Metal Transition of Strained VO₂/TiO₂ Multilayered Films
B. Chen^{1,*} and H. Ohta²
¹ Information Science and Technology, Hokkaido University ² Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University
- 11:45-12:05 **18a-O06** ZnO 中の水素複合欠陥
ホ シンイ^{1,*}, 片瀬 貴義¹, 井手 啓介¹, 細野 秀雄^{1,2}, 神谷 利夫^{1,2}
¹ 東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所, 東京工業大学 元素戦略研究センター
- 12:05-12:25 **18a-O07** 原子状水素アニールによる半導体と金属の自然酸化膜と熱酸化膜の還元
部家 彰^{1,*}, 住友 弘二¹
¹ 兵庫県立大学
- 12:25-12:45 **18a-O08** タンパク質分子接合を含む CNT サブモノレイヤーFET による電荷輸送特性評価
森岡 璃久^{*}, 趙 ヨンユン, 阿部 竜, Manish Pandey, 辨天 宏明, 中村 雅一
奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科

12:45-13:40 昼食

13:40-14:15 ショートプレゼンテーション

14:15-15:45 ポスターセッション

18p-P01 OICTによる通電加熱時におけるSiウェハ内の過渡的温度分布の3次元イメージング技術

松口康太郎^{1,*}, Y. Jiawen¹, 花房宏明¹, 東清一郎¹

¹⁾ 広島大学先進理工系科学研究科

18p-P02 反応性大気圧熱プラズマジェットを用いたフォトレジストの局所超高速エッチング

加藤 響^{1,*}, 花房 宏明¹, 東 清一郎¹

¹⁾ 広島大学大学院 先進理工系科学研究科

18p-P03 化学溶液堆積法によるHf-Zr-O膜へのドーピングと強誘電性評価

橋口 渉^{1,*}, モヒート², 徳光 永輔³

¹⁾ 北陸先端科学技術大学院大学 先端科学研究科

18p-P04 原子状水素アニールによる酸化グラフェン還元の下地効果と処理時間依存性

平田 将大^{1,*}, 藤淵 暁昇¹, 部家 彰¹, 住友 弘二¹

¹⁾ 兵庫県立大学

18p-P05 900°Cの熱CVDで合成したグラフェンの炭化時間依存性

榎本陽菜^{1,*}, 市川和典¹, 大島多美子²

¹⁾ 松江工業高等専門学校 電子制御工学科 ²⁾ 佐世保工業高等専門学校 電気電子工学科

18p-P06 ミストCVD法により成膜したNiO薄膜へのグラフェン合成

吉田宇良^{1,*}, 市川和典¹, Liuli², 川原村敏幸²

¹⁾ 松江工業高等専門学校 電子制御工学科 ²⁾ 高知工科大学 総合研究所 ナノテクノロジー研究センター

18p-P07 ユウロピウム錯体の合成と塗布法による赤色発光薄膜の作製

上田 英明^{1,*}, 大谷 直毅¹

¹⁾ 同志社大学 理工学研究科

18p-P08 CVD合成により成膜したZnS:Mn薄膜蛍光体層の光学特性と無機ELへの応用

北脇 大靖^{1,*}, 和辻 浩一¹, 山本 伸一¹

¹⁾ 龍谷大院工

18p-P09 微分FT-IRスペクトルを用いた低温酸化Si膜の評価

普 迪^{*}, 堀田 將

北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科

18p-P10 光トリガードTDRによるOPVの発電初期過程

益子朋晃¹, 戒能智¹, 黒政颯¹, 高野晃希¹, 藤井伸太郎¹, 三野弘文², 酒井正俊^{1,*}, 工藤 一浩¹

¹⁾ 千葉大院工 ²⁾ 千葉大院国際

18p-P11 巨大ゼーベック効果における光キャリアドーピングの影響

杉山拓弥^{1,*}, 趙ヨンユン¹, 阿部竜¹, 服部修也¹, 平本 昌宏², 辨天 宏明¹, M. Pandey¹, 中村雅一¹

¹⁾ 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 ²⁾ 分子科学研究所

- 18p-P12** 加熱触媒体により生成したラジカルを用いた酸化グラフェンの表面処理
藤本健汰^{1,*}、部家彰¹⁾、住友弘二¹⁾
^{1*)} 兵庫県立大学 材料・放射工学専攻
- 18p-P13** 有機半導体高分子ポリアルキルチオフェンの電荷キャリア：DFT 計算ならびに電場誘起 ESR 計測
下位幸弘^{1,*}、黒田新一²⁾、田中久暁³⁾
¹⁾ 産総研 CD-FMat²⁾ 元豊田理研³⁾ 名古屋大学大学院 工学研究科
- 18p-P14** 全固体熱トランジスタに及ぼす固体電解質厚さの影響
吉村充生^{1,*}、楊 倩^{2,3)}、卞 志平²⁾、ジョヘジュン⁴⁾、太田裕道⁴⁾
¹⁾ 北海道大学工学部²⁾ 北海道大学情報科学院³⁾ 江蘇大学化学化工学科⁴⁾ 北海道大学電子科学研究所
- 18p-P15** 強誘電体薄膜を用いたメモキャパシタのアナログ動作の評価と文字補正応用
石崎勇真^{1,*}、田中欧介¹⁾、桑原拓実¹⁾、河西秀典¹⁾、松田時宜²⁾、木村睦¹⁾
¹⁾ 龍谷大学 理工学部²⁾ 近畿大学
- 18p-P16** LiF 被膜形成によるリチウムイオン電池用シリコン負極の特性改善
小倉一真¹⁾、上嶋凌大¹⁾、春田正和^{1,*}
¹⁾ 近畿大学産業理工学部
- 18p-P17** Fe 薄膜上に合成したダイヤモンド半導体のダイオード特性
竹谷隼斗^{*}、市川和典
松江工業高等専門学校 電子制御工学科
- 18p-P18** 熱 CVD による鉄基板上のダイヤモンド合成の冷却依存性・水素依存性
福間八紘^{*}、市川和典
松江工業高等専門学校 電子制御工学科
- 18p-P19** シジミの貝殻由来の炭酸カルシウムを用いたコンデンサの作製
森脇碧^{*}、榎本陽菜、市川和典
松江工業高等専門学校 電子制御工学科
- 18p-P20** マグネトロンスパッタによる酸化ガリウム薄膜の作製とシリコンドーピングの検討
李陳毅展^{1,*}、大谷直毅¹⁾
¹⁾ 同志社大学大学院 理工学研究科
- 18p-P21** 静電噴霧法による酸化ガリウム薄膜の作製
芝原拓哉^{1,*}、李陳毅展¹⁾、大谷直毅¹⁾
¹⁾ 同志社大学 理工学研究科
- 18p-P22** 光電子収量分光法による InGaZnO 薄膜のバンド構造解析
渡邊悠太^{*}、中野渡俊喜、服部吉晃、北村雅季
神戸大学大学院工学研究科電気電子工学専攻
- 18p-P23** 薄膜酸化物半導体 Ga-Sn-O の熱電特性のプロセス依存性
山本佑平^{1,*}、伊藤良¹⁾、柴田尚樹²⁾、松田時宜³⁾、河西秀典^(1,2)、木村睦^{1,2)}
¹⁾ 龍谷大学 理工学研究科電子情報学専攻、²⁾ 龍谷大学 理工学部電子情報学科³⁾ 近畿大学 理工学部電気電子通信工学科
- 18p-P24** メモリスタとキャパシタを用いたシナプス素子の評価
谷内田健太^{1,*}、桑原拓海¹⁾、阿部祥也¹⁾、澤井一輝¹⁾、松田時宜^{2,3)}、河西秀典¹⁾、木村睦^{1,4)}
¹⁾ 龍谷大学 理工学研究科²⁾ 近畿大学 電気電子通信工学科³⁾ 龍谷大学 革新的材料・

- 18p-P25** **アモルファス $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ を用いた ReRAM**
門野太助^{1*)}, 井手啓介¹⁾, 片瀬貴義^{1,2)}, 平松秀典^{1,3)}, 細野秀雄^{1,3)}, 神谷利夫^{1,3)}
¹⁾ 東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所 ²⁾ 科学技術振興機構 さ
きがけ ³⁾ 東京工業大学 元素戦略研究センター
- 18p-P27** **Ti 錯体水溶液を用いたペロブスカイト型太陽電池の電子輸送層に関する検討**
井宗祐梨菜^{1*)}, 來福至¹⁾, 河西秀典¹⁾, 浦岡行治¹⁾
¹⁾ 奈良先端科学技術大学院大学
- 18p-P28** **Electric Field Thermopower Modulation Analyses of $\text{InGaO}_3(\text{ZnO})_m$ ($m = 1 - 30$) Thin Film Transistors**
P. Ghediya^{1,*)}, H. Yang^{1,2)}, T. Fujimoto³⁾, Y. Zhang^{4,5)}, Y. Matsuo¹⁾, Y. Magari¹⁾ and H. Ohta^{1,*)}
¹⁾ Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University, ²⁾ Institute of Optoelectronic Technology, Beijing Jiaotong University, ³⁾ Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University, ⁴⁾ Institute of Quantum and Sustainable Technology, Jiangsu University, ⁵⁾ Foshan (Southern China) Institute for New Materials
- 18p-P29** **ドナー・アクセプタ型高分子半導体用いた塗布型有機フローティングゲートメモリの素子特性と動作機構**
西田直之^{1,*)}, 永瀬隆^{1,2)}, 小林隆史^{1,2)}, 内藤裕義^{1,2)}
¹⁾ 大阪公立大学 大学院工学研究科 電子物理系専攻 ²⁾ 大阪公立大学 分子エレクトロニクデバイス研究所
- 18p-P30** **$\text{In}_5\text{GaZnO}_{10}$ 薄膜をチャンネル層とする電界効果トランジスタの特性評価**
中野渡俊喜^{*)}, 渡邊悠太, 服部吉晃, 北村雅季
神戸大大学院工学研究科電気電子工学専攻
- 18p-P31** **シングルターゲットによる RF マグネトロンスパッタリング法を用いた $\text{Hf}_{0.5}\text{Zr}_{0.5}\text{O}_2$ の成膜条件の最適化**
福井 智貴^{1,*)}, 枝広 龍磨¹⁾, 篠田 太陽¹⁾, 松田 時宜²⁾, 河西 秀典¹⁾, 木村 睦¹⁾
¹⁾ 龍谷大学 ²⁾ 近畿大学
- 18p-P32** **有機薄膜太陽電池におけるドナー・アクセプタドナー混合比と移動度の関係**
明里 直輝^{1,*)}, 杉田 椋哉²⁾, 小林 隆史^{1,4)}, 永瀬 隆^{1,4)}, 内藤 裕義^{3,4)}
¹⁾ 大阪公立大学 大学院工学研究科 電子物理系専攻 ²⁾ 大阪公立大学 大学院工学研究科 電子・数物系専攻 ³⁾ 大阪公立大学 大学院工学研究科 物質化学生命系 専攻 ⁴⁾ 大阪公立大学 分子エレクトロニクデバイス研究所

オーラルセッション5：パワーデバイスの新展開

15:45-16:25 18p-I01 自動車用パワーデバイス開発の現状とキー課題（招待講演）

三宅裕樹*

株式会社ミライズテクノロジーズ

16:25-16:45 18p-O02 スパッタリング法によるアモルファス酸化ガリウム薄膜の作製とダイオード特性の評価

嵯峨野太一^{1,*}, 井手啓介¹, 片瀬貴義¹, 平松秀典^{1,2}, 細野秀雄², 神谷利夫^{1,2}

¹ 東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所 ² 東京工業大学 元素戦略研究センター

16:45-17:05 18p-O03 Development of A Real-Time Temperature Measurement Technique for SiC Wafer During Rapid Plasma Processing Based on Optical-Interference Contactless Thermometry (OICT)

J. Yu*, K. Matsuguchi, H. Hanafusa and S. Higashi

Hiroshima Univ.

17:05-17:25 18p-O04 p 型二硫化モリブデン TFT の原子状酸素処理及びアニール処理による特性改善

荒井大地^{1*}, 清水耕作¹

¹ 日本大学大学院 生産工学研究科

17:25-17:40 588 企業コマーシャル4・休憩

閉会式・アワード授与式

17:25-17:40 神谷 利夫（第19回研究集会 実行委員長）

東工大